

High Power Infrared Emitter (850 nm)

IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung

Version 1.0 / gemäß: OS-PCN-2009-021-A2

SFH 4350



Features:

- High Power Infrared LED
- Emission angle $\pm 13^\circ$
- Very high radiant intensity
- Short switching times
- UL version available

Applications

- Infrared Illumination for cameras
- Data transmission
- Sensor technology
- Smoke detectors

Notes

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

**ATTENTION -Observe Precautions For Handling
-Electrostatic Sensitive Device**



Besondere Merkmale:

- Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
- Abstrahlwinkel $\pm 13^\circ$
- Sehr hohe Strahlstärke
- Kurze Schaltzeiten
- UL Version erhältlich

Anwendungen

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- Datenübertragung
- Sensorik
- Rauchmelder

Hinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

**ATTENTION -Observe Precautions For Handling
-Electrostatic Sensitive Device**



Ordering Information

Bestellinformation

Type: Typ:	Radiant Intensity Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_e [\text{mW/sr}]$	Ordering Code Bestellnummer
SFH 4350	200 (≥ 63)	Q65110A2091

Note: Measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Anm.: Gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Maximum Ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operation and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur	$T_{op}; T_{stg}$	-40 ... 100	$^\circ\text{C}$
Reverse voltage Sperrspannung	V_R	5	V
Forward current Durchlassstrom	I_F	100	mA
Surge current Stoßstrom ($t_p \leq 100 \mu\text{s}$, $D = 0$)	I_{FSM}	1	A
Total power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	180	mW
Thermal resistance junction - ambient ^{1) page 11} Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung ^{1) Seite 11}	R_{thJA}	450	K / W

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Emission wavelength Zentrale Emissionswellenlänge ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	λ_{peak}	860	nm
Centroid Wavelength Schwerpunktwellenlänge der Strahlung ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	$\lambda_{\text{centroid}}$	850	nm
Spectral bandwidth at 50% of I_{max} Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	$\Delta\lambda$	30	nm
Half angle Halbwinkel	φ	± 13	°
Active chip area Aktive Chipfläche	A	0.09	mm ²
Dimensions of active chip area Abmessungen der aktiven Chipfläche	L x W	0.3 x 0.3	mm x mm
Rise and fall time of I_e (10% and 90% of $I_{e\text{ max}}$) Schaltzeit von I_e (10% und 90% von $I_{e\text{ max}}$) ($I_F = 100\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$)	t_r, t_f	12	ns
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	V_F	1.5 (≤ 1.8)	V
Forward voltage Durchlassspannung ($I_F = 1\text{ A}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$)	V_F	2.4 (≤ 3)	V
Reverse current Sperrstrom ($V_R = 5\text{ V}$)	I_R	not designed for reverse operation	μA
Total radiant flux Gesamtstrahlungsfluss ($I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$)	Φ_e	70	mW

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Temperature coefficient of I_e or Φ_e Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_I	-0.5	% / K
Temperature coefficient of V_F Temperaturkoeffizient von V_F ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_V	-0.7	mV / K
Temperature coefficient of wavelength Temperaturkoeffizient der Wellenlänge ($I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$)	TC_λ	0.3	nm / K

Grouping ($T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)**Gruppierung**

Group Gruppe	Min Radiant Intensity Min Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \min} [\text{mW} / \text{sr}]$	Max Radiant Intensity Max Strahlstärke $I_F = 100 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$ $I_{e, \max} [\text{mW} / \text{sr}]$	Typ Radiant Intensity Typ Strahlstärke $I_F = 1 \text{ A}$, $t_p = 25 \text{ } \mu\text{s}$ $I_{e, \text{typ}} [\text{mW} / \text{sr}]$
SFH 4350-V	63	125	750
SFH 4350-AW	100	200	1200
SFH 4350-BW	160	320	1900
SFH 4350-CW	250	500	3000

Note: measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

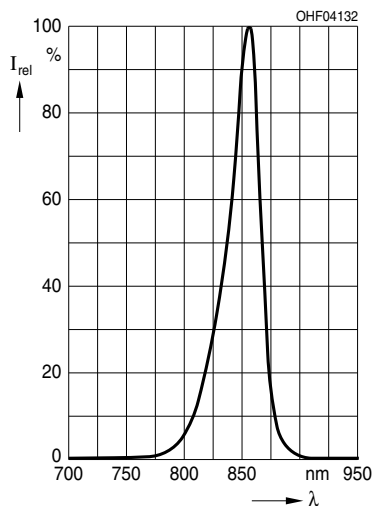
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).

Anm.: gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).

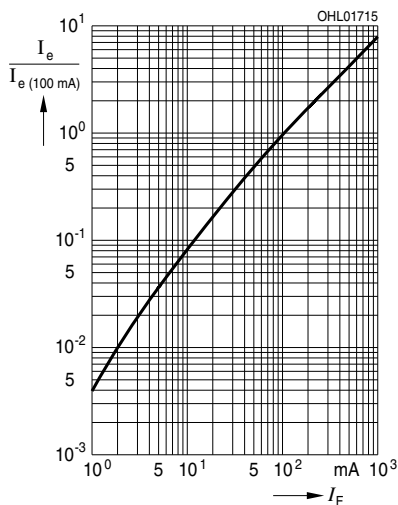
Relative Spectral Emission Relative spektrale Emission

$$I_{\text{rel}} = f(\lambda), T_A = 25^\circ\text{C}$$



Radiant Intensity Strahlstärke

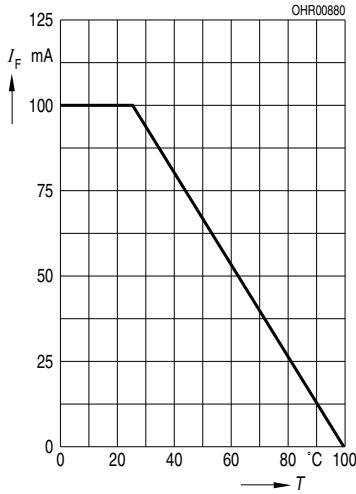
$$I_e / I_e(100 \text{ mA}) = f(I_F), \text{ single pulse, } t_p = 25 \mu\text{s}, T_A = 25^\circ\text{C}$$



Max. Permissible Forward Current

Max. zulässiger Durchlassstrom

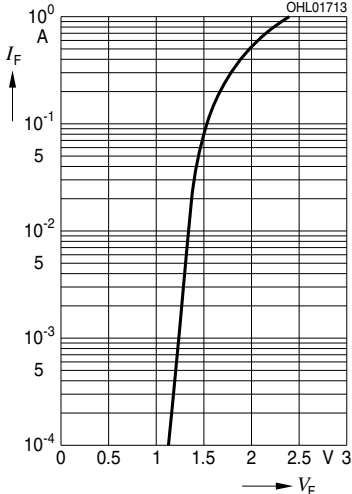
$I_{F, \max} = f(T_A), R_{thJA} = 450 \text{ K/W}$



Forward Current

Durchlassstrom

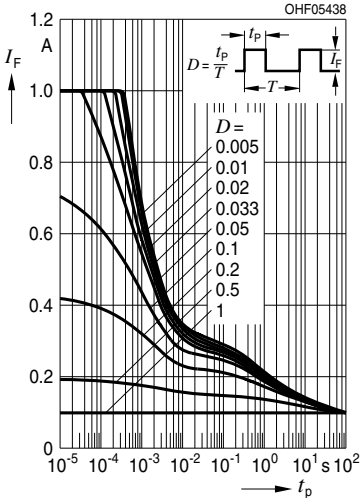
$I_F = f(V_F)$, single pulse, $t_p = 100 \mu\text{s}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Permissible Pulse Handling Capability

Zulässige Pulsbelastbarkeit

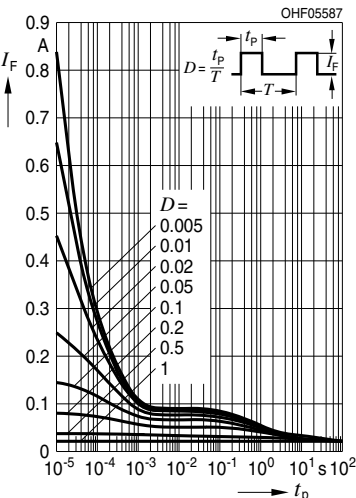
$I_F = f(t_p)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$



Permissible Pulse Handling Capability

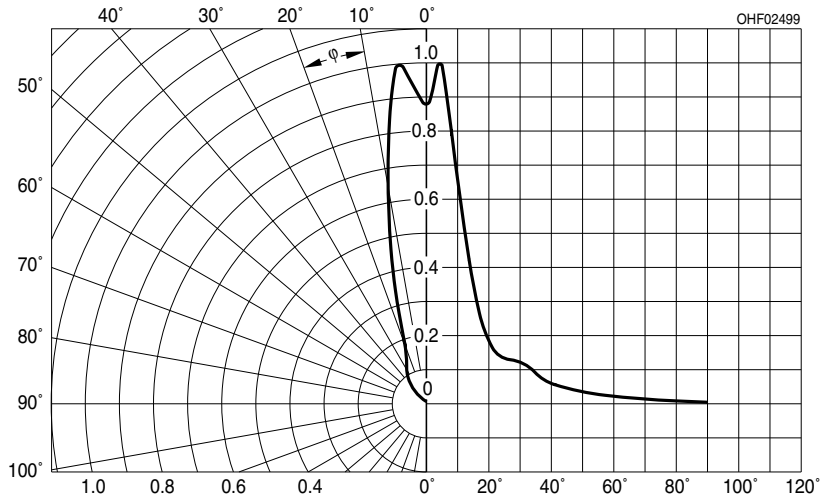
Zulässige Pulsbelastbarkeit

$I_F = f(t_p)$, $T_A = 85^\circ\text{C}$, duty cycle $D = \text{parameter}$

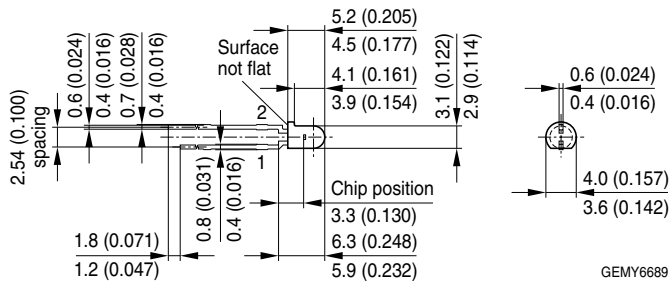


Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik

$I_{rel} = f(\varphi)$



Package Outline
Maßzeichnung



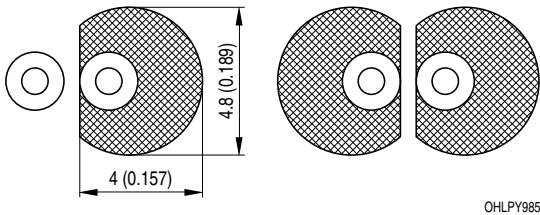
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

Pinning
Anschlussbelegung

Pin Anschluss	Description Beschreibung
1	Anode / Anode
2	Cathode / Kathode

Package	3mm Radial (T 1), ($\frac{1}{10}$ "), Epoxy, clear
Gehäuse	3mm Radial (T 1), ($\frac{1}{10}$ "), Harz, klar

Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpad design
TTW Soldering / Wellenlöten (TTW)

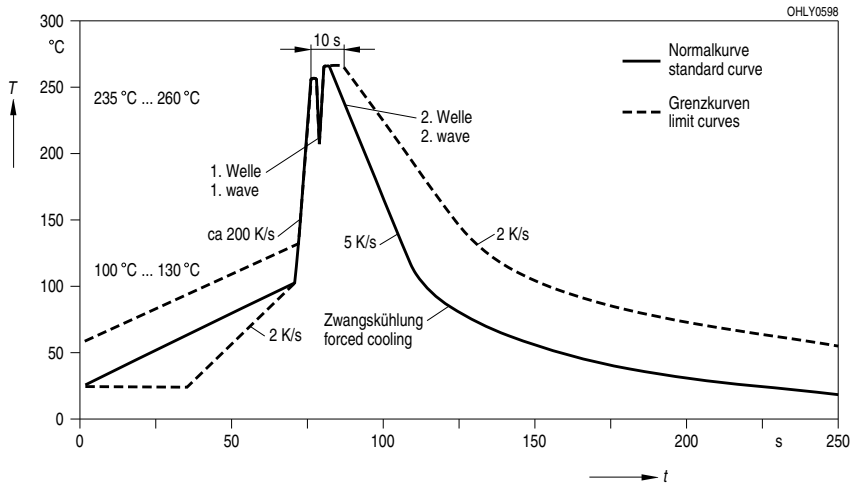


Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).

TTW Soldering**Wellenlöten (TTW)**

(acc. to IEC 61760-1)

IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW



Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved.

Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- ¹⁾ **Thermal resistance:** junction -ambient, mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm² each

Glossar

- ¹⁾ **Wärmewiderstand:** Sperrschicht -Umgebung, bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm²

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

HS and China RoHS compliant product



符合欧盟 RoHS 指令的要求；
国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。